Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Навчально-науковий Інститут Комп'ютерних інформаційних технологій Кафедра комп'ютеризованих систем управління

Лабораторна робота №2 з дисципліни «Комп'ютерна електроніка» на тему: «Дослідження біполярного транзистора» Варіант №

> Виконав: студент ННІКІТ СП-225 Клокун Владислав Перевірив: Андрєєв О.В.

1 Мета та основні завдання роботи

- 1. Ознайомитись з принципом дії, схемами ввімкнення і ВАХ біполярного транзистора.
- 2. Набути практичних навичок у побудові вольт-амперних характеристик біполярного тразистора.
- 3. Набути практичних навичок у побудові навантажувальної прямої транзистора і визначенні h-параметрів.
- 4. Дослідити вплив положення робочої точки транзистора на форму вихідного сигналу.
- 5. Вивчити схеми ввімкнення біполярних транзисторів і їхні вольт-амперні характеристики.
- 6. Вивчити методику побудови навантажувальної прямої, вибору робочої точки і визначення h-параметрів.
- 7. Освоїти методику побудови за вхідною напругою інших струмів і напруг біполярного транзистора.

2 Хід роботи

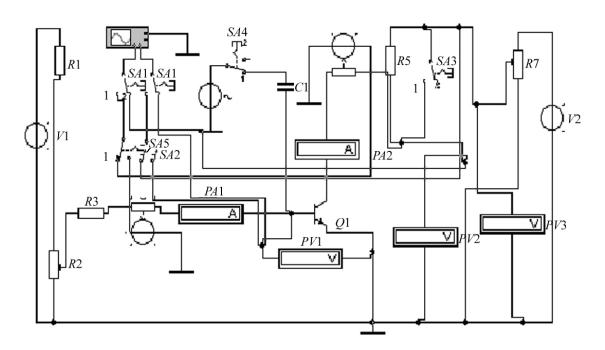


Рис. 1: Принципова електрична схема віртуальної лабораторної установки

2.1 Дослідження біполярного транзистора в статичному режимі

2.1.1 Побудова вхідних вольт-амперних характеристик

Готуємо лабораторну установку до роботи. Для цього встановлюємо перемикачі SA1, SA2, SA3, SA4 у положення «1», «2», «1», «2» відповідно. Вмикаємо осцилограф та встановлюємо такі налаштування:

Time Base 0,2 ms/div A/B, Auto Channel A 2 mV/div DC Channel B 100 mV/div DC

Встановлюємо напругу $E_{\rm K}=0$ В за допомогою потенціометра R7 (100%). Вмикаємо лабораторну установку на моделювання. Змінюємо значення вхідної напруги $U_{\rm EE}$ за допомогою потенціометра R2 від 0 до 100%. При цьому на екрані осцилографа з'явилась вхідна характеристика транзистора, знята при напрузі $U_{\rm K}$. Вимикаємо установку. Відкриваємо аналізатор графіків та встановлюємо такі налаштування:

Left Axis							
Range	Minimum	0	Maximum	0,01			
Bottom Axis							
Range	Minimum	0	Maximum	0,01			
Divisions	Number	0	Precision	1			

Перерисовуємо вхідну характеристику $U_{\rm K}=f(I_{\rm B}), U_{\rm K}={\rm const.}$ Встановлюємо напругу $E_{\rm K}=10~{\rm B}$ за допомогою потенціометра R7 (приблизно 70%). Будуємо графік. Встановлюємо напругу $E_{\rm K}=20~{\rm B}$ за допомогою потенціометра R7 (43%). Будуємо графік.

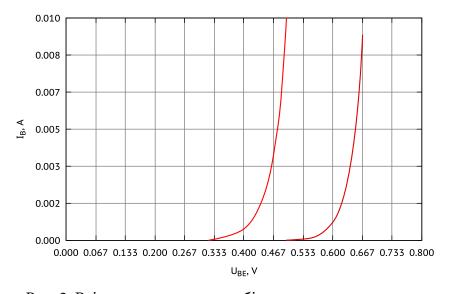


Рис. 2: Вхідна характеристика біполярного транзистора

2.1.2 Побудова вихідних вольт-амперних характеристик

Готуємо лабораторну установку до продовження роботи. Для цього переводимо перемикач SA2 в положення «1». Змінюємо масштаби на осцилографі на такі значення:

Channel A 200 mV/div DC Channel B 5 V/div DC

Встановлюємо колекторну напругу $U_{\rm K}=0$ за допомогою потенціометра R7 зі значенням 100%. Вмикаємо лабораторну установку на моделювання. Встановлюємо струм бази $I_{\rm E}=632,5$ мкА потенціометром R2 зі значенням приблизно 20%. Змінюємо значення $U_{\rm K}$ від 0 до 40 В за допомогою потенціометра R7 зі значеннями від 100% до 0%. Вимикаємо лабораторну установку.

Відкриваємо аналізатор графіків і встановлюємо такі налаштування:

Left Axis

Range	Minimum	0	Maximum	0,09		
Bottom Axis						
Range	Minimum	0	Maximum	40		
Divisions	Number	8	Precision	0		

Встановлюємо струм бази $I_{\rm B}=2,23\,{\rm mA}$ за допомогою потенціометра R2 зі значенням 30%. Зарисовуємо другу характеристику.

Встановлюємо струм бази $I_{\rm B}=5{,}13\,{\rm mA}$ за допомогою потенціометра R2 зі значенням 50%. Зарисовуємо третю характеристику.

Вимикаємо моделювання лабораторної установки та аналізатор графіків.

2.2 Дослідження біполярного транзистора в режимі посилення

Встановлюємо перемикач SA3 в положення «2». Встановлюємо напругу $E_{\rm K}=10$ В за допомогою потенціометра R7 зі значенням 71%. Задаємо вхідні напруги $U_{\rm BE}=392\,{\rm mB}$ і $I_{\rm B}\approx0,65\,{\rm mkA}$ за допомогою потенціометра R2 зі значенням 15%.

Вимірюємо координати робочої точки на вихідній характеристиці за допомогою приладів *PV2*, *PA2*:

$$PV2 = U_{K1} = 10 \,\mathrm{B}$$
 (1)

$$PA2 = I_{K} = 11 \text{ MKA}$$
 (2)

Таким чином, точка A має координати (10; 0,000 11). Звертаємо увагу, що PV3 = PV2.

Збільшуємо вхідну напругу до $U_{\rm BE}\approx 632\,{\rm mB}$ та напругу $I_{\rm B}\approx 3,15\,{\rm mA}$ за допомогою потенціометра R2 зі значенням 44%.

Вимірюємо координати другої робочої точки $I_{\rm K2}, U_{\rm KE2}$ за допомогою приладів PV2, PA2:

$$PV2 = U_{K2} = 3,778 \,\mathrm{B}$$
 (3)

$$PA2 = I_{K2} = 52,39 \,\text{MA}$$
 (4)

Таким чином, точка B має координати (3,778; 0,052 39). Вимикаємо моделювання. За координатами двох точок на графіку сім'ї вихідних зарактеристик будуємо навантажувальну пряму (рис. 3). Обчислюємо за законом Ома величину $R_{\rm K}$:

$$R_{
m K}=rac{U_{
m KE}}{I_{
m K}}pproxrac{7\,{
m B}}{0,025\,{
m A}}pprox280\,{
m Om}$$

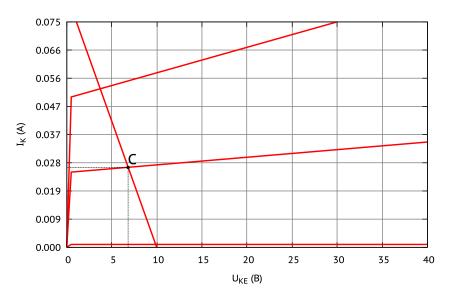


Рис. 3: Сімейство вихідних характеристик з навантажувальною прямою

2.3 Дослідження біполярного транзистора в режимі посилення гармонійних коливань

Досліджуємо біполярний транзистор у режимі посилення гармонійних коливань. Для цього на вході транзистора задаємо робочу точку по середині лінійної ділянки вхідних характеристик для $E_{\rm K} \approx 10~{\rm B}.$

Відкриваємо осцилограф і налаштовуємо його таким чином:

Time Base 0,5 ms/div Y/T, Auto Channel A 50 mV/div AC Channel B 200 mV/div AC

Відкриваємо вікно налаштувань генератора синусоїдних коливань і встановлюємо значення амплітуди вхідного струму $U_{\rm BX}=13\,{\rm MB}$ та частоту коливань $F=1\,{\rm k}\Gamma$ ц.

Підключаємо генератор до вхідного ланцюга біполярного транзистора, встановивши перемикач SA4 у положення «1», та вмикаємо генератор.

Перерисовуємо осцилограми вхідної і вихідної напруг. Визначаємо амплітуди вхідної та вихідної напруг: $U_{\rm E}=18,74\,{\rm mB},\,U_{\rm K}=351,27\,{\rm mB}.$

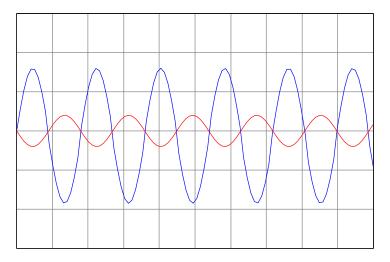


Рис. 4: Осцилограма вхідного та вихідного сигналів

За допомогою потенціометра R2 (71%) зміщуємо робочу точку в область режиму насичення: $I_{\rm B}\approx 6,6$ мА, $U_{\rm BE}\approx 647$ мВ. Перерисовуємо осцилограми вхідної і вихідної напруг. Визначаємо амплітуди вхідної та вихідної напруг: $U_{\rm B}\approx 17,35$ мВ, $U_{\rm K}\approx 325,43$ мВ. Вимикаємо осцилограф і моделювання.

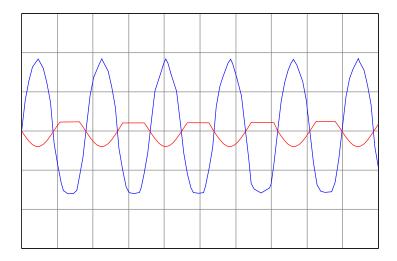


Рис. 5: Осцилограма вхідного та вихідного сигналів

Зазначимо, що зі зміною положення робочої точки змінилась амплітуда сигналів, а також стали помітними візуальні спотворення на осцилограмах.

3 Висновки

Виконавши лабораторну роботу №2 на тему «Дослідження біполярного транзистора» ми досягли таких цілей:

- 1. Ознайомились з принципом дії, схемами ввімкнення і вольт-амперними характеристиками біполярного транзистора.
- 2. Набули практичних навичок з побудови вольт-амперних характеристик.
- 3. Набули практичних навичок з побудови навантажувальної прямої транзистора.
- 4. Дослідили вплив положення робочої точки транзистора на форму вихідного сигналу.
- 5. Вивчили схеми ввімкнення біполярних транзисторів і їх вольт-амперні характеристики.
- 6. Освоїли методику побудови за вхідною напругою інших струмів і напруг біполярного транзистора.

Виявлено, що при збільшенні $U_{\rm KE}$ ($U_{\rm KE}>0$) вхідна вольт-амперна характеристика зміщується вправо та вниз. Крім того, сигнал, що проходить через біполярний транзистор у режимі посилення гармонійних коливань, піддається нелінійним спотворенням.